

Docket No.: PEK-IN-1257

IN THE UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE

Applicant : ANDREAS KYEK
Filed : CONCURRENTLY HEREWITH
Title : APPARATUS FOR PRODUCING SECONDARY ELECTRONS, A
SECONDARY ELECTRODE, AND AN ACCELERATION
ELECTRODE

CLAIM FOR PRIORITY

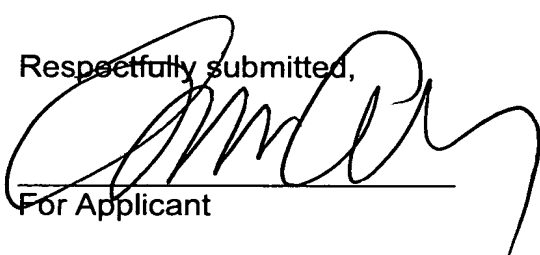
Commissioner for Patents
P.O. Box 1450
Alexandria, VA 22313-1450

Sir:

Claim is hereby made for a right of priority under Title 35, U.S. Code, Section 119,
based upon the German Patent Application 102 54 416.6, filed November 21, 2002.

A certified copy of the above-mentioned foreign patent application is being submitted
herewith.

Respectfully submitted,



For Applicant

LAURENCE A. GREENBERG
REG. NO. 29,308

Date: November 21, 2003

Lerner and Greenberg, P.A.
Post Office Box 2480
Hollywood, FL 33022-2480
Tel: (954) 925-1100
Fax: (954) 925-1101

/kf

BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND



Prioritätsbescheinigung über die Einreichung einer Patentanmeldung

Aktenzeichen: 102 54 416.6

Anmeldetag: 21. November 2002

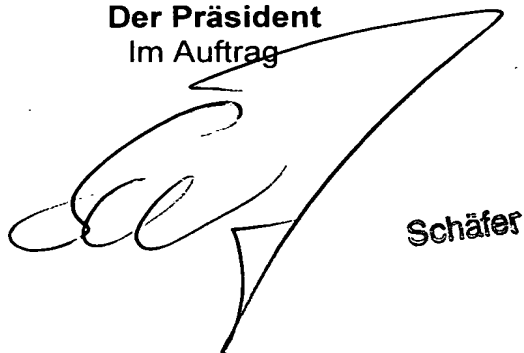
Anmelder/Inhaber: Infineon Technologies AG, München/DE

Bezeichnung: Vorrichtung zum Erzeugen von Sekundärelektronen,
insbesondere Sekundärelektrode und Beschleunigungs-
elektrode

IPC: H 01 J 37/073

Die angehefteten Stücke sind eine richtige und genaue Wiedergabe der ursprünglichen Unterlagen dieser Patentanmeldung.

München, den 30. Oktober 2003
Deutsches Patent- und Markenamt
Der Präsident
Im Auftrag



Schäfer

Beschreibung

Vorrichtung zum Erzeugen von Sekundärelektronen, insbesondere Sekundärelektrode und Beschleunigungselektrode

5

Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung zum Erzeugen von Sekundärelektronen, die folgende Bestandteile enthält:

- eine Primärelektrode, mit deren Hilfe sich Primärelektronen erzeugen lassen, und
- 10 - eine Beschleunigungselektrode, mit deren Hilfe sich die Primärelektronen beschleunigen lassen.

Die Vorrichtung wird bspw. an einen Freiraum angeordnet, der bspw. zum Durchtritt eines Ionenstrahls, zur Aufnahme eines Plasmas und/oder zur Aufnahme eines Werkstücks bzw. eines zu bearbeitenden Materials dient.

Der Ionenstrahl enthält beispielsweise Bor-, Phosphor- oder Arsen-Ionen. In einem Plasma sind Atomen Elektronen entzogen worden, so dass die dabei entstandenen Ionen positive Ladungen haben. Positiv geladene Ionen werden auch als Kationen bezeichnet.

Die Primärelektrode ist beispielsweise ein sehr dünner Draht mit einem sehr kleinen Krümmungsradius. Aufgrund des Krümmungsradius entsteht eine Koronaentladung. In ausreichendem Abstand von der Primärelektrode treten aufgrund der Koronaentladung nur Ladungen von der Polarität der Elektrode auf. Das bedeutet, dass die Primärelektrode zum Erzeugen von Elektronen ein negatives Potential besitzt. Beispielsweise beträgt der Durchmesser des Primärelektrodendrahtes 30 µm (Mikrometer).

Die Beschleunigungselektrode liegt auf einem anderen Potential als die Primärelektrode, beispielsweise auf Massepotential. Durch das sich zwischen der Beschleunigungselektrode und der Primärelektrode ausbildende elektrische Feld werden die

Primärelektronen zur Beschleunigungselektrode hin beschleunigt. Die Primärelektroden treten durch Öffnungen in der Beschleunigungselektrode hindurch und behalten aufgrund des fehlenden elektrischen Beschleunigungsfeldes hinter der Beschleunigungselektrode ihre Richtung bei.

Beispielsweise werden solche Vorrichtungen zum Erzeugen von Sekundärelektronen in Ionenimplantationsanlagen bei der Herstellung von integrierten Schaltkreisen eingesetzt, um Aufladungen entgegenzuwirken, die auf einem Wafer durch die Kationen entstehen können.

Es ist Aufgabe der Erfindung, eine einfach aufgebaute Vorrichtung zum Erzeugen von Sekundärelektronen anzugeben, die insbesondere Aufladungen auf wirksame Weise entgegenwirkt oder solche Aufladungen wirksam verhindert. Außerdem sollen eine Sekundärelektrode und eine Beschleunigungselektrode angegeben werden, die insbesondere in einer Vorrichtung zum Erzeugen von Sekundärelektronen einsetzbar sind.

Die auf die Vorrichtung gerichtete Aufgabe wird gemäß einem ersten Aspekt durch eine Vorrichtung mit den im Patentanspruch 1 angegebenen Merkmalen gelöst. Weiterbildungen sind in den Unteransprüchen angegeben.

Die Erfindung geht von der Überlegung aus, dass die Primärelektronen aufgrund der Beschleunigungsspannung eine vergleichsweise hohe Energie haben, beispielsweise mehrere 100 eV (Elektronenvolt). Aufgrund der hohen Energie besteht beispielsweise die Möglichkeit, dass Primärelektronen die direkt zu einem Halbleiter-Wafer gelangen dort eine starke negative Aufladung bewirken, die ebenfalls nicht gewollt ist. Beispielsweise können die Primärelektronen von einem Ionenstrahl mitgerissen werden. Um solche oder ähnliche Vorgänge zu verhindern, enthält bei der Vorrichtung gemäß dem ersten Aspekt die Beschleunigungselektrode mindestens eine Durchgangsöffnung, die sich schräg durch die Beschleunigungselekt-

rode hindurch erstreckt. Damit treffen die Primärelektronen auf eine Seitenwand der Durchgangsöffnung, bevor sie die Vorrichtung verlassen und z.B. den Freiraum erreichen. Weiterhin werden beim Auftreffen der Primärelektronen Sekundärelektronen erzeugt, die eine vergleichsweise kleine Energie haben. Außerdem verlängert sich die Durchgangsöffnung auf Grund der Schräglage über die Materialdicke der Elektrode hinaus.

- 10 Bei der Vorrichtung gemäß erstem Aspekt hat die Beschleunigungselektrode damit eine Dreifachfunktion, nämlich:
- Erzeugung der Beschleunigungsspannung,
 - Erzeugung von Sekundärelektronen, und
 - Unterbrechen des direkten Weges von Primärelektronen nach
- 15 außen, z.B. zum Freiraum.

Bei einem zweiten Aspekt der Erfindung enthält die Vorrichtung zum Erzeugen von Sekundärelektronen zusätzlich zu der Beschleunigungselektrode und zur Primärelektrode eine Sekundärelektrode, die beim Auftreffen von Primärelektronen Sekundärelektronen erzeugt. Die Sekundärelektrode ist vorzugsweise auf der von der Primärelektrode abgewandten Seite der Beschleunigungselektrode angeordnet. Damit liegt die Sekundärelektrode zwischen der Beschleunigungselektrode und dem Freiraum. Auf der Sekundärelektrode treffen Primärelektronen auf und erzeugen Sekundärelektronen. Weil die Sekundärelektrode von der Beschleunigungselektrode räumlich getrennt ist, gelangen die Sekundärelektronen ohne Störungen aufgrund des elektrischen Feldes zum Erzeugen der Primärelektronen und zu deren Beschleunigung nach außen, z.B. zum Freiraum. Weil die Sekundärelektrode außerdem auf der gleichen Seite des Freiraums liegt, wie die Primärelektrode wird die Anzahl von Primärelektronen verringert, die den Freiraum erreichen.

- 35 Bei einer Weiterbildung der Vorrichtung gemäß zweitem Aspekt enthält die Sekundärelektrode mindestens eine Durchgangsöffnung, die sich schräg durch die Sekundärelektrode hindurch

erstreckt. Diese Weiterbildung beruht auf den gleichen Überlegungen wie die Erfindung gemäß dem ersten Aspekt. Die Sekundärelektrode hat eine Doppelfunktion, nämlich:

- Erzeugung der Sekundärelektronen beim Auftreffen von Primärelektronen, und
- Unterbrechen des direkten Weges von Primärelektronen nach außen, z.B. zum Freiraum.

An Stelle oder zusätzlich zu einer sich schräg durch die Beschleunigungselektrode bzw. die Sekundärelektrode hindurch erstreckenden Durchgangsöffnung lassen sich auch andere Maßnahmen treffen, um mit Hilfe der Durchgangsöffnung den Durchtritt von Primärelektronen zu behindern oder zu verhindern. Beispielsweise lässt sich eine Elektrode mit einer Durchgangsöffnung, die in Normalenrichtung der Elektrodenfläche verläuft, bezogen auf den Freiraum bzw. den Ionenstrahl geneigt oder mit einem bestimmten Versatz von Durchgangsöffnung und Primärelektrode anordnen, um den Durchtritt von Primärelektronen zu behindern und somit die gleichen Wirkungen zu erreichen, wie oben erläutert.

Bei einer für beide Aspekte geltenden Weiterbildung ist die Durchgangsöffnung ein Langloch, dass sich vorzugsweise parallel zur Primärelektrode bzw. zu einem Draht der Primärelektrode erstreckt. Das Langloch lässt sich beispielsweise mit Hilfe einer Fräsmaschine auf einfache Art und Weise herstellen. Auch die Herstellung von schrägen Langlöchern ist mit einer Fräsmaschine ohne weiteres möglich. Alternativ werden Lamellen verwendet.

30

Bei einer Ausgestaltung liegen die Seitenflächen der Durchgangsöffnung in der Auftreffrichtung des Hauptteils der in die Durchgangsöffnung gelangenden Primärelektronen einander überlappend oder fluchtend. Durch eine fluchtende Anordnung wird erreicht, dass einerseits keine Primärelektronen direkt nach außen, z.B. zum Freiraum, gelangen und dass andererseits die Auftrefffläche in der Durchgangsöffnung im Verhältnis zur

35

Länge der Durchgangsöffnung groß ist. Damit können viele Sekundärelektronen auf einfache Art durch die Durchgangsöffnung hindurch nach außen, z.B. zum Freiraum, gelangen.

- 5 Bei einer Weiterbildung ist die Durchgangsöffnung in einem Winkel zwischen 30° und 70° zur Flächennormalen der Elektrode im Bereich der Durchgangsöffnung geneigt angeordnet. Der geeignete Winkel hängt von der Dicke der Elektrode ab. Bei einer Dicke von etwa 5 mm ist beispielsweise ein Winkel von
10 55° besonders geeignet. Bei einer Ausgestaltung gilt für den Winkel:

$$\tan(90^\circ - w) = d/b,$$

- wobei w den Winkel, d die Dicke der Elektrode mit der Durchgangsöffnung und b die Breite der Durchgangsöffnung bezeichnen.
15

- Bei einer Ausgestaltung liegt der Abstand zwischen den Seitenwänden der Durchgangsöffnung zwischen 2 mm und 6 mm. Der
20 geeignete Abstand hängt auch von der Dicke der Elektrode mit der Durchgangsöffnung ab. Beispielsweise ist bei einer Elektroden-
dicke von etwa 5 mm und einem Neigungswinkel von 55° ein Abstand zwischen den Seitenwänden von 4 mm besonders geeignet.

- Bei einer anderen Weiterbildung ist pro Primärelektrode nur eine Durchgangsöffnung vorgesehen. Dadurch ergibt sich eine einfach aufgebaute Vorrichtung. Bei einer Ausgestaltung enthält die Vorrichtung nur eine Primärelektrode. Durch diese
30 Maßnahme vereinfacht sich der Aufbau der Vorrichtung weiter.

- Alternativ enthält die Vorrichtung jedoch mehrere Primärelektroden, denen jeweils mindestens eine Durchgangsöffnung zugeordnet ist. Durch unterschiedliche Durchtrittsrichtungen
35 der Durchgangsöffnungen lassen sich die von den Primärelektronen verschiedener Primärelektroden erzeugten Sekundärelektronen an einer bestimmten Stelle außerhalb der Vorrichtung,

z.B. im Freiraum konzentrieren, z.B. in einer Elektronenwolke. Dadurch wird bei gleichbleibender Baulänge und gleicher Neutralisierungswirkung gewährleistet, dass weniger Primärelektronen bspw. zum Auftreffort des Ionenstrahls gelangen können, d.h. bspw. zum Halbleiterwafer oder zu einem zu bestrahlenden Werkstoff.

Als Material für die Elektrode mit der Durchgangsöffnung wird bei einer anderen Weiterbildung Aluminium, eine Aluminiumlegierung, Graphit, eine Graphitverbindung oder Aluminiumoxid Al_2O_3 verwendet. Aluminium Al und Graphit C haben bei Energien von 300 eV eine Ausbeute von 1 oder doch von der Größenordnung 1. Das bedeutet, dass jedes auftreffende Primärelektron ein Sekundärelektron erzeugt. Die Ausbeute wird auch als Sekundärelektronenemissionskoeffizient bezeichnet. Der Sekundärelektronenemissionskoeffizient von Aluminiumoxid ist mindestens doppelt so hoch wie der von Aluminium bzw. Graphit.

Eine aufgeraute Oberfläche der Elektrode mit der Durchgangsöffnung führt zu einer höheren Sekundärelektronenemission. Bei einer Ausgestaltung beträgt die mittlere Rauheit der Oberfläche 6,3 μm .

Bei einer Weiterbildung mit separater Beschleunigungselektrode und Sekundärelektrode enthält die Beschleunigungselektrode mehr als 100, mehr als 500 oder sogar mehr als 1000 Öffnungen. Die Öffnungen sind beispielsweise Bohrungen mit einem Durchmesser von etwa 1 mm. Alternativ lassen sich jedoch auch Drahtgitter einsetzen.

30

Bei einer Weiterbildung wird als Material für die Beschleunigungselektrode Aluminium oder eine Aluminiumlegierung eingesetzt. Bei einer Ausgestaltung wird Aluminium mit einer Reinheit von 99,9 % oder mehr als 99,9 % eingesetzt. Dieses Material ist insbesondere bei der Herstellung von integrierten Schaltungsanordnungen als Elektrodenmaterial geeignet. Die mittlere Oberflächenrauheit der Beschleunigungselektrode

35

beträgt bei einer Ausgestaltung 4,3 μm , d.h. die Beschleunigungselektrode ist glatter als die Sekundärelektrode.

Bei einer Weiterbildung ist die Primärelektrode bzw. sind die
5 Primärelektroden parallel zur Ausbreitungsrichtung des Ionenstrahls angeordnet. Diese Art der Anordnung wird insbesondere bei sogenannten Hochstrom-Ionenimplantierungsanlagen eingesetzt. In diesen Anlagen ist der Strom des Ionenstrahls größer als 1 mA. Beispielsweise liegt der Ionenstrom im Bereich
10 zwischen 1 und 25 mA. Die Primärelektroden lassen sich bei der Weiterbildung beispielsweise um den Ionenstrahl herum anordnen.

Bei einer alternativen Weiterbildung ist die Primärelektrode
15 bzw. sind die Primärelektroden quer zur Ausbreitungsrichtung des Ionenstrahls angeordnet, vorzugsweise in einem Winkel von 90°. Diese Anordnung wird insbesondere bei Anlagen verwendet, bei denen der Ionenstrahl beispielsweise gemäß einer Abtastbewegung geführt wird, d.h. gescannt wird. Insbesondere wird
20 eine solche Abtastbewegung bei Mittelstrom-Ionenimplantierungsanlagen eingesetzt, bei denen der Ionenstrom Werte kleiner 1 mA hat. Jedoch gibt es auch Hochstrom-Ionenimplantierungsanlagen, bei denen der Ionenstrahl eine Abtastbewegung ausführt.

Die Erfindung betrifft außerdem eine Sekundärelektrode mit den Merkmalen der oben erwähnten Sekundärelektroden, d.h. insbesondere mit einer Durchgangsöffnung, die sich schräg durch die Sekundärelektrode erstreckt. Damit gelten die oben
30 genannten technischen Wirkung auch für die Sekundärelektrode.

Weiterhin betrifft die Erfindung eine Beschleunigungselektrode, die insbesondere die Merkmale der oben genannten Beschleunigungselektrode hat. Insbesondere enthält die Beschleunigungselektrode mehr als 100, mehr als 500 oder mehr
35 als 1000 Öffnungen. Damit gelten die oben erwähnten technischen Wirkungen ebenfalls für diese Beschleunigungselektrode.

Beispielsweise lässt sich eine erfindungsgemäße Vorrichtung oder eine erfindungsgemäße Elektrode auf einfache Art und Weise in eine Ionenimplantieranlage vom Typ EATON Implanter einsetzen, insbesondere in einer Anlage vom Typ NV 8250 P. Die unten angegebenen Maße betreffen diesen Anlagentyp. Jedoch lassen sich auch andere Anlagentypen auf ähnliche Art und Weise verändern, um die Erfindung zu nutzen.

Im Folgenden werden Ausführungsbeispiele der Erfindung an Hand der beiliegenden Zeichnungen erläutert. Darin zeigen:

Figur 1 den Aufbau einer Erzeugungsvorrichtung für Sekundärelektronen mit Hilfe einer Koronaentladung,

Figuren 2A und 2B

Ansichten einer Sekundärelektrode, und

Figur 3 eine Draufsicht auf eine Beschleunigungselektrode.

Figur 1 zeigt den Aufbau einer Elektronen-Erzeugungsvorrichtung 10, die einen Durchtrittsraum 12 bzw. eine Kammer für den Durchtritt eines Ionenstrahls 14 enthält. Der Ionenstrahl 14 wird mit Hilfe von nicht dargestellten Einheiten einer Ionenimplantieranlage erzeugt, nämlich mit:

- einer Ionenquelle, z.B. einer HF-Quelle (Hochfrequenz),
- einer Masseseparatoranordnung, z.B. einem Magneten, und
- einer Beschleunigungsstrecke.

Der Ionenstrahl 14 wird vor oder nach dem Durchtritt durch den Durchtrittsraum 12 beispielsweise mit Hilfe eines Ablenksystems abgelenkt, so dass er eine Abtastbewegung ausführt.

Der Durchtrittsraum 12 wird nach unten hin von einer abschirmenden Schwenkelektrode 16 begrenzt. Die Schwenkelektrode 16 ist um einen Punkt P schwenkbar gelagert. In einer Normalbetriebsart der Erzeugungsvorrichtung 10 befindet sich die Schwenkelektrode 16 in der in Figur 1 dargestellten Lage, d.h. der Ionenstrahl 14 kann ungehindert durch den Durch-

trittsraum 12 treten. Während einer Testbetriebsart wird die Schwenkelektrode 16 nach oben in den Durchtrittsraum 12 geschwenkt, so dass der Ionenstrahl 14 nicht mehr auf einen Wafer 18 auftreffen kann.

5

Nach oben hin wird der Durchtrittsraum 12 von einer Sekundärelektrode 20 begrenzt, die sich parallel zu der Schwenkelektrode 16 in Normalbetriebsart erstreckt. Der Aufbau der Sekundärelektrode 20 wird unten näher erläutert.

10

An der Außenseite der Sekundärelektrode 20 ist in einem geringen Abstand eine Primärelektronen-Erzeugungsvorrichtung 26 angeordnet, die zum Erzeugen von Primärelektronen dient. Die Elektronenerzeugungsvorrichtung 26 enthält drei Glühdrähte 28, 30 und 32, die zueinander parallel z.B. in einem gleichmäßigen Abstandsraster aufgereiht sind. Die Glühdrähte 28, 30 und 32 verlaufen im Winkel von 90° zur Ausbreitungsrichtung des Ionenstrahls 14. Die Glühdrähte 28 bis 32 sind von einem Dreifachreflektor 34 umgeben, der drei voneinander getrennte Aussparungen 36, 38 und 40 hat, in deren Mitte sich jeweils ein Glühdraht 28, 30 bzw. 32 erstreckt. Den Öffnungen der Aussparungen 36 bis 40 gegenüberliegend befindet sich in einem geringen Abstand zum Dreifachreflektor 34 eine in einer Ebene liegende Beschleunigungselektrode 42, die beispielsweise ein durch Bohrungen gebildetes Gitter oder ein Drahtgitter ist.

30

Die Schwenkelektrode 16, die Sekundärelektrode 20 und die Beschleunigungselektrode 42 bestehen im Ausführungsbeispiel aus Aluminium. Die Glühdrähte 28 bis 32 bestehen beispielsweise aus Wolfram. Als Material für den Dreifachreflektor 34 ist ebenfalls Aluminium geeignet.

35

Die Sekundärelektrode 20 enthält drei schräg in der Sekundärelektrode 20 angeordnete Schlitz 50, 52 und 54, die in dieser Reihenfolge den Glühdrähten 28, 30 bzw. 32 benachbart sind. Damit liegen die Schlitz 50 und 52 näher am Eintritts-

ort des Ionenstrahls 14 in den Durchtrittsraum 12 als der Schlitz 54. Die Seitenwände der Schlitze 50 und 52 liegen parallel zueinander. So schließen die Seitenwände der Schlitze 50 und 52 mit einer Normalen der vom Durchtrittsraum 12 abgewandten Oberfläche der Sekundärelektrode 20 einen Winkel von -60° ein, wobei minus bedeutet, dass der Winkel von der Normalen in einer Richtung verläuft, die entgegengesetzt der Richtung des Uhrzeigers ist. Die Seitenwände des Schlitzes 54 liegen parallel zueinander, jedoch in einer Richtung geneigt, die der Neigungsrichtung der Seitenwände der Schlitze 50 und 52 entgegengesetzt ist. So schließen die Seitenwände des Schlitzes 54 mit einer Normalen der vom Durchtrittsraum 12 abgewandten Oberfläche der Sekundärelektrode 20 einen Winkel von $+60^\circ$ ein. Die Dicke der Sekundärelektrode 20 und der Winkel sind so bemessen, dass spitze Kanten der Schlitze 50, 52 und 54 jeweils zueinander in der Normalenrichtung der Oberfläche der Sekundärelektrode 20 fluchten. Eintrittsöffnungen der Schlitze 50, 52 und 54 sind in dieser Reihenfolgen den Glühdrähten 28, 30 bzw. 32 gegenüberliegend angeordnet.

An dem Dreifachreflektor 34 und an den Glühdrähten 28 bis 32 liegt ein Potential von -300 V (Volt) an. Eine diesem Potential überlagerte Spannung, insb. eine Gleichspannung, von bspw. 30 Volt , führt zu einem Stromfluss, der die Glühdrähte 28 bis 32 zum Glühen bringt. Durch die Glühdrähte 28 bis 32 fließen dann beispielsweise 5 A (Ampere) pro Glühdraht 28 bis 32. An der Schwenkelektrode 16, an der Sekundärelektrode 20 und an der Beschleunigungselektrode 42 liegt ein Potential von 0 V an. Somit werden beispielsweise Primärelektronen vom Glühfaden 28 zu der näher am Eintrittsort des Ionenstrahls 14 gelegenen Seitenfläche des Schlitzes 50 hin beschleunigt. Nach dem Durchtritt durch die Beschleunigungselektrode 42 treffen diese Primärelektronen 60 auf diese Seitenfläche auf und erzeugen dort jeweils ein Sekundärelektron. Die so entstehenden Sekundärelektronen 62 werden vom Ionenstrahl 14 angezogen und gelangen auf Grund der Richtwirkung des Schlitz-

zes 50 auf einem zur Ausbreitungsrichtung des Ionenstrahls geneigten Weg in eine Elektronenwolke 64.

5 Auf gleiche Art und Weise gelangen vom Glühdraht 30 durch die Beschleunigungselektrode 42 hindurch Primärelektronen 66 zu der näher am Eintrittsort des Ionenstrahls 14 liegenden Seitenfläche des Schlitzes 52. Die Primärelektronen 66 erzeugen Sekundärelektronen 68, die vom Ionenstrahl 14 angezogen werden und in die Elektronenwolke 64 gelangen.

10

Vom Glühdraht 32 aus werden Primärelektronen 70 zur Beschleunigungselektrode 42 hin beschleunigt. Die Primärelektronen 70 durchdringen die Beschleunigungselektrode 42 und gelangen auf die weiter weg vom Eintritt des Ionenstrahls 14 in dem Durchtrittsraum 12 gelegene Seitenfläche des Schlitzes 54. Die
15 Primärelektronen 70 erzeugen Sekundärelektronen 72, die ebenfalls in die Elektronenwolke 64 gelangen. Während die Sekundärelektronen 62 und 68 hauptsächlich parallel zueinander in die Elektronenwolke 64 gelangen, sind die Sekundärelektronen
20 72 auf Grund der anderen Neigungsrichtung des Schlitzes 54 den Sekundärelektronen 62 und 68 entgegengerichtet. Auch zufällig durch den Schlitz 54 tretende Primärelektronen 70 werden durch die Neigung des Schlitzes 54 vom Wafer 18 weggerichtet.

Figur 2A zeigt eine Sekundärelektrode 100 für einen EATON
Implanter vom Typ NV-8250, d.h. insbesondere für 6-Zoll Waferimplantationen bzw. nach einem Umbau für 8-Zoll Waferimplantationen. Die Sekundärelektrode 100 wird an Stelle der Sekundärelektrode 20 in einer Elektronenerzeugungsvorrichtung
30 eingesetzt, die nur einen Glühdraht enthält. Ein in der Sekundärelektrode 100 angeordneter Schlitz 102 entspricht beispielsweise dem Schlitz 50, 52 oder 54. Die Sekundärelektrode 100 hat einen rechteckförmigen Grundkörper, an dessen Längsseiten mittig zwei Befestigungsstege 104 und 106 angeordnet
35 sind. Die Befestigungsstege 104 und 106 haben eine Länge, die etwa $1/3$ der Länge des Grundkörpers der Sekundärelektrode 100

entspricht. Der Befestigungssteg 104 ragt etwa 10 mm über den Grundkörper der Sekundärelektrode 100 hinaus. Dagegen ragt der Befestigungssteg 106 nur etwa 3 mm über den Grundkörper der Sekundärelektrode 100 hinaus. Der Grundkörper der Sekundärelektrode 100 hat eine Länge von 162 mm und eine Breite von etwa 36 mm. Eine Öffnung des Schlitzes 102 erstreckt sich nahe an dem Befestigungssteg 106 entlang fast der gesamten Länge des Grundkörpers. Im Ausführungsbeispiel beträgt die Länge des Schlitzes 102 ohne Einbeziehungen von Rundungen an den Enden des Schlitzes 102 150 mm.

In Figur 2A ist außerdem die Lage einer Schnittebene A gezeigt, die quer zur Längsachse der Sekundärelektrode 100 in der Mitte der Sekundärelektrode 100 liegt.

15

Figur 2B zeigt die Sekundärelektrode 100 entlang des Querschnittes, der in der Schnittebene A liegt. Die Dicke der Sekundärelektrode 100 beträgt etwa 5 mm. Wie in Figur 2B dargestellt, liegen Seitenwände 110 und 112 des Schlitzes 102 zu einer Normalen N um einen Winkel von -55° geneigt. Der Abstand zwischen den Seitenwänden 110 und 112 beträgt 4 mm.

20

Die Sekundärelektrode 100 besteht aus Aluminium, nämlich aus dem Material Al 99. Die mittlere Rauheit der Oberfläche beträgt $6,3 \mu\text{m}$.

25

Figur 3 zeigt eine Beschleunigungselektrode 150, die an Stelle der Beschleunigungselektrode 42 in der gleichen Anlage eingesetzt wird, in der auch die Sekundärelektrode 100 verwendet wird. Die Beschleunigungselektrode 150 hat eine Länge von 162 mm und eine Breite von 11 mm. Innerhalb eines Rahmens 152 befinden sich eine Vielzahl von Bohrungen 160 bis 166, beispielsweise mehr als 500 Bohrungen. Die Bohrungen 160 bis 166 haben jeweils einen Durchmesser von 1 mm und sind in sechs zueinander parallel verlaufenden Reihen 170 bis 180 aufgereiht. Die Bohrungen 160, 162 zweier benachbarter Reihen 170, 172 sind um 0,65 mm zueinander versetzt. Die Abstände

30

35

zwischen den inneren Reihen 174 und 176, zwischen den mittleren Reihen 172, 178 bzw. zwischen den äußeren Reihen 170 und 180 betragen 1,13 mm, 3,38 mm bzw. 5,63 mm. Innerhalb einer Reihe 170 bis 180 haben zueinander benachbarte Bohrungen 164, 166 einen auf den Mittelpunkt der Bohrungen 164 und 166 bezogenen Abstand von jeweils 1,3 mm.

Die Beschleunigungselektrode 150 ist in Figur 3 stark vergrößert dargestellt. Die Beschleunigungselektrode 150 besteht aus Aluminium Al 99.9, so dass nur eine kleine Anzahl von Fremdatomen aus der Beschleunigungselektrode 150 austritt. Implantationsverfahren lassen sich so mit einer hohen Ausbeute durchführen. Die mittlere Rauheit der Oberfläche beträgt 4,3 μm . Die Dicke des Rahmens 152 beträgt 1,5 mm. Innerhalb des Rahmens 152 ist die Beschleunigungselektrode 150 1 mm dick.

Bei einem anderen Ausführungsbeispiel wird bei der Elektronen-Erzeugungsvorrichtung 10 die Beschleunigungselektrode 42 weggelassen. Die Funktionen der Beschleunigungselektrode 42 werden dann zusätzlich von der Sekundärelektrode 20 übernommen.

Bei einem weiteren Ausführungsbeispiel werden an Stelle der schrägen Schlitzlamellen verwendet, die bspw. in einem Rahmen gehalten werden. Jeweils zwei benachbarte Lamellen bilden eine Durchgangsöffnung, die sich schräg durch den Rahmen erstreckt. Jede Lamelle ist ein langgestrecktes dünnes Metallplättchen, bspw. aus Aluminium.

Patentansprüche

1. Vorrichtung (10) zum Erzeugen von Sekundärelektronen,

5 mit mindestens einer Primärelektrode (28 bis 32) zum Erzeugen von Primärelektronen (60),

und mit einer Beschleunigungselektrode zum Beschleunigen der Primärelektronen,

10 wobei die Beschleunigungselektrode mindestens eine Durchgangsöffnung enthält, die sich schräg durch die Beschleunigungselektrode hindurch erstreckt und/oder die den Durchtritt von Primärelektronen (60) behindert.

15 2. Vorrichtung (10) zum Erzeugen von Sekundärelektronen,

mit mindestens einer Primärelektrode (28 bis 32) zum Erzeugen von Primärelektronen (60),

mit einer Beschleunigungselektrode (42) zum Beschleunigen der Primärelektronen,

20 und mit einer Sekundärelektrode (20) zum Erzeugen von Sekundärelektronen beim Auftreffen der beschleunigten Primärelektronen.

3. Vorrichtung (10) nach Anspruch 2, d a d u r c h g e -
k e n n z e i c h n e t , dass die Sekundärelektrode (20) mindestens eine Durchgangsöffnung (50) enthält, die sich schräg durch die Sekundärelektrode (20) hindurch erstreckt und/oder die den Durchtritt von Primärelektronen (60) behindert.

30 4. Vorrichtung (10) nach Anspruch 1 oder 3, d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , dass die Durchgangsöffnung (50, 102) durch ein Langloch mit vorzugsweise parallel zueinander angeordneten Seitenflächen (110, 112) oder durch Lamellen gebildet wird,

35 und/oder dass sich Seitenflächen (110, 112) der Durchgangsöffnung (102) in Auftreffrichtung von in die Durchgangsöffnung (102) gelangenden Primärelektronen (60) überlappen oder

fluchtend zur Normalenrichtung (N) der die Durchgangsöffnung (102) enthaltenden Fläche angeordnet sind.

5. Vorrichtung (10) nach einem der Ansprüche 1, 3 oder 4, dadurch gekennzeichnet, dass die Durchgangsöffnung (50) eine Durchgangsrichtung hat, die zur Flächennormalen (N) der Elektrode (100) im Bereich der Durchgangsöffnung (50) in einem Winkel mit einem Betrag zwischen 30° und 70° angeordnet ist, vorzugsweise in einem Winkel mit einem

10 Betrag von 55° ,
und/oder dass für den Winkel gilt:

$$\tan(90^\circ - w) = d/b,$$

wobei w den Winkel, d die Dicke der Elektrode mit der Durchgangsöffnung (50) und b die Breite der Durchgangsöffnung (50) bezeichnen,

15 und/oder dass der Abstand von Seitenwänden (110, 112) der Durchgangsöffnung (50) zwischen 2 mm und 6 mm liegt, vorzugsweise bei 4 mm.

20 6. Vorrichtung (10) nach einem der Ansprüche 1, 3, 4 oder 5, dadurch gekennzeichnet, dass pro Primärelektrode (28 bis 32) nur jeweils eine Durchgangsöffnung (50 bis 54) vorgesehen ist,

und/oder dass mehrere Primärelektroden (28 bis 32) vorhanden sind, denen jeweils mindestens eine Durchgangsöffnung (50 bis 54) zugeordnet ist,

wobei vorzugsweise mindestens zwei Durchgangsöffnungen (50, 54) voneinander verschiedene Schräglagen haben,

und/oder dass die Vorrichtung (10) nur eine Primärelektrode (28) enthält.

7. Vorrichtung (10) nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die die Durchgangsöffnung (50) enthaltende Elektrode (20) aus Aluminium oder einer Aluminiumlegierung besteht, vorzugsweise aus Al 99 oder einem noch reineren Aluminium,

oder dass die die Durchgangsöffnung (50) enthaltende Elektrode aus Graphit besteht oder mehr als 60 Masseprozent Graphit enthält,

oder dass die die Durchgangsöffnung (50) enthaltende Elektrode (20) Aluminiumoxid enthält,

und/oder dass die die Durchgangsöffnung (50) enthaltende Elektrode (20) eine mittlere Oberflächenrauheit zwischen 5 und 8 μm hat.

8. Vorrichtung (10) nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass beim Vorhandensein von Beschleunigungselektrode (42) und Sekundärelektrode (20) die Beschleunigungselektrode (150) mindestens 100, mindestens 500 oder mindestens 1000 Öffnungen (160 bis 166) enthält, vorzugsweise Bohrungen oder Maschen in einem Drahtgitter.

9. Vorrichtung (10) nach Anspruch 8, dadurch gekennzeichnet, dass die Beschleunigungselektrode (150) aus Aluminium oder einer Aluminiumlegierung besteht, vorzugsweise aus Al 99.9 oder einem noch reineren Aluminium, und/oder dass die mittlere Oberflächenrauheit der Beschleunigungselektrode (150) kleiner als die mittlere Oberflächenrauheit der Sekundärelektrode (20) ist und vorzugsweise in dem Bereich zwischen 2,5 und 6 μm liegt.

10. Vorrichtung (10) nach einem der vorhergehenden Ansprüche, gekennzeichnet durch einen Freiraum (12), der zum Durchtritt eines Ionenstrahls (14) verwendet wird, wobei der Ionenstrahl (14) vorzugsweise auf ein Werkstück gerichtet wird, insbesondere auf ein Halbleitersubstrat (18),

oder der zur Aufnahme eines Plasmas dient,

und/oder der zur Aufnahme eines zu bearbeitenden Materials oder Werkstücks dient.

11. Vorrichtung nach Anspruch 10, d a d u r c h g e k e n n -
z e i c h n e t , dass die Primärelektrode parallel zur Aus-
breitungsrichtung des Ionenstrahls (14) angeordnet ist,
oder dass die Primärelektrode (28) quer zur Ausbreitungsrich-
5 t u n g des Ionenstrahls (14) angeordnet ist.

12. Sekundärelektrode (20, 100), insbesondere Sekundärelekt-
rode mit den Merkmalen einer Sekundärelektrode (20, 100) nach
einem der vorhergehenden Ansprüche,
10 d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , dass die Sekundär-
elektrode (20, 100) mindestens eine Durchgangsöffnung (50,
102) enthält, die sich schräg durch die Sekundärelektrode
(20, 100) hindurch erstreckt.

13. Beschleunigungselektrode (42, 150), insbesondere Be-
schleunigungselektrode (42, 150) mit den Merkmalen einer
Beschleunigungselektrode (42, 150) nach Anspruch 8 oder 9,
d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , dass die Beschleuni-
gungselektrode (42, 150) mehr als 100, mehr als 500 oder mehr
20 a l s 1000 Öffnungen (160 bis 166) enthält.

Zusammenfassung

Vorrichtung zum Erzeugen von Sekundärelektronen, insbesondere Sekundärelektrode und Beschleunigungselektrode

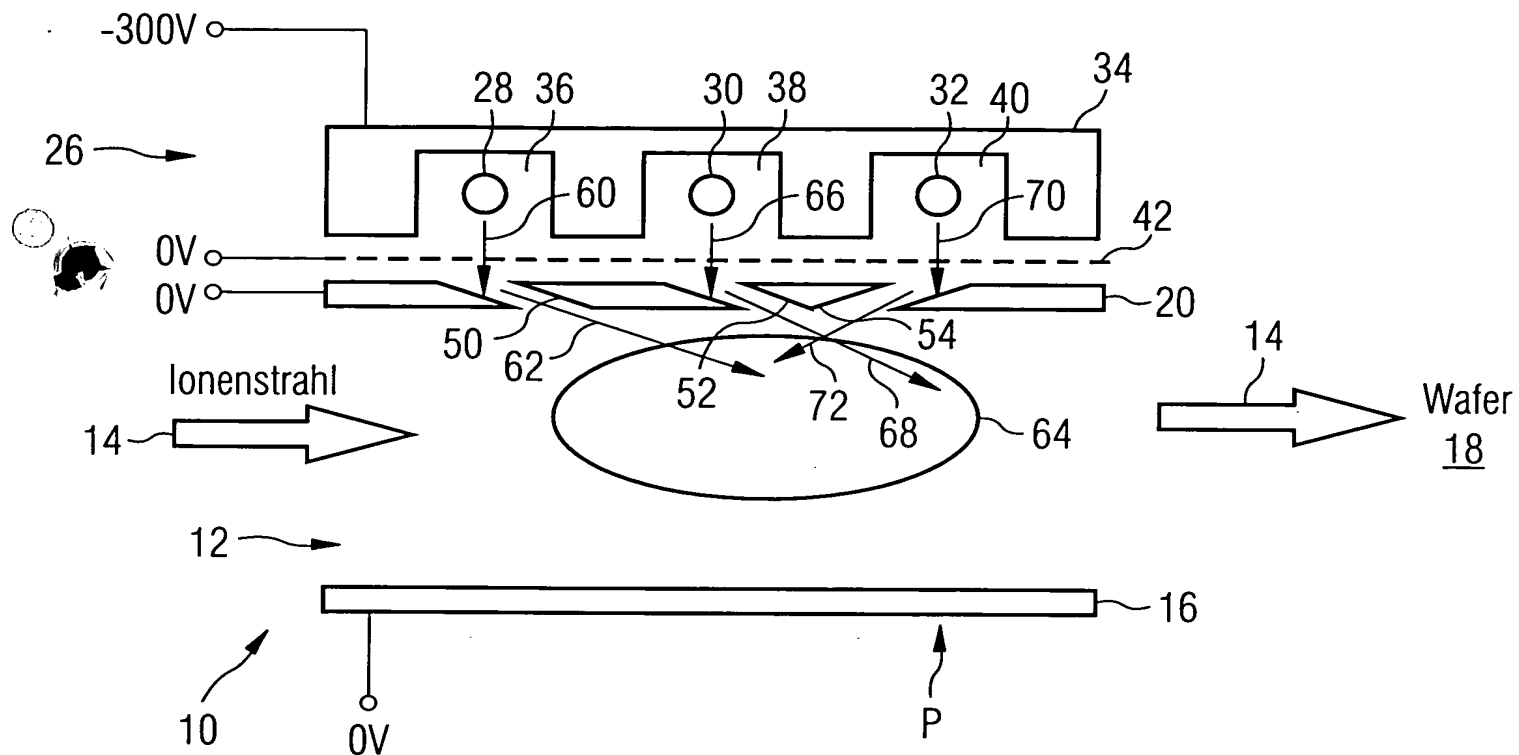
5

Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung (10), die eine Primärelektrode (28) und eine Beschleunigungselektrode (42) enthält. Die Beschleunigungselektrode oder alternativ eine zusätzliche Sekundärelektrode (20) enthält einen Schlitz (50), der sich schräg durch die Beschleunigungselektrode bzw. die Sekundärelektrode (20) erstreckt. Durch diese Maßnahme lassen sich Sekundärelektronen auf sehr wirksame Weise erzeugen.

10

15 (Figur 1)

FIG 1



Bezugszeichenliste

10	Elektronen-Erzeugungsvorrichtung
12	Durchtrittsraum
14	Ionenstrahl
16	Schwenkelektrode
P	Punkt
18	Wafer
20	Sekundärelektrode
26	Primärelektronen-Erzeugungsvorrichtung
28 bis 32	Glühdraht
34	Dreifachreflektor
36 bis 40	Aussparung
42	Beschleunigungselektrode
50 bis 52	Schlitz
60	Primärelektronen
62	Sekundärelektrode
64	Elektronenwolke
66	Primärelektronen
68	Sekundärelektronen
70	Primärelektronen
72	Sekundärelektronen
100	Sekundärelektrode
102	Schlitz
104, 106	Befestigungssteg
A	Schnittebene
110, 112	Seitenwand
N	Normale
150	Beschleunigungselektrode
152	Rahmen
160 bis 166	Bohrung
170 bis 180	Reihe

FIG 2B

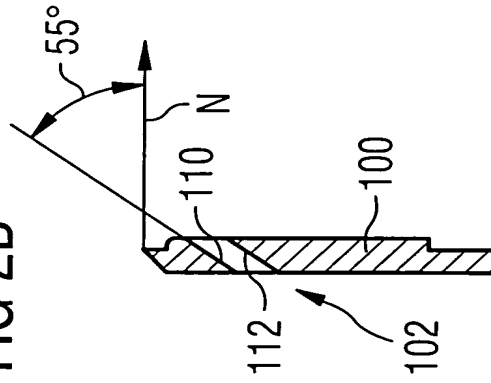


FIG 2A

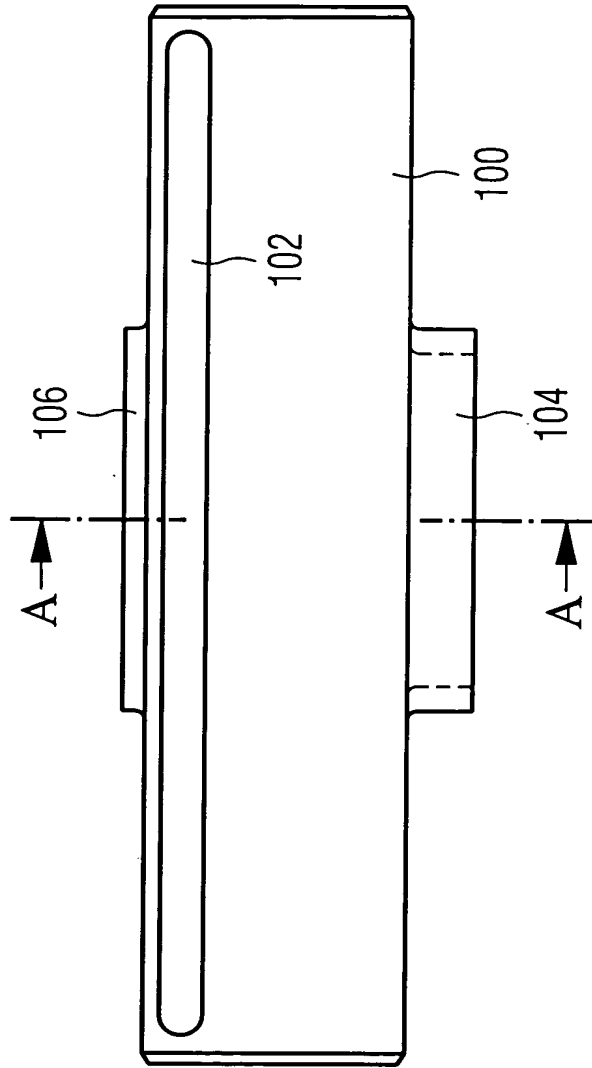
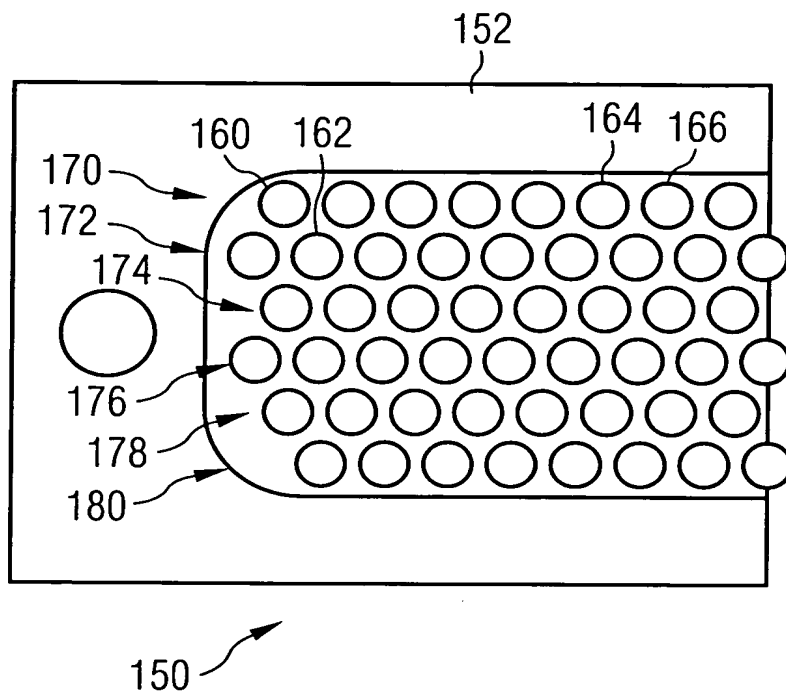


FIG 3



DOCKET NO.:
 APPLIC. NO.:
 APPLICANT:
 L. and Greenberg, P.A.
 A Box 2480
 Fort Wood, FL 33022
 Tel. (954) 952-1100